2009年1月

Jan , 2009

文章编号: 10002324X(2009)0120018205

新型太阳能材料 C₆₀ Pt(dppp)配合物的合成及性能

杨绳岩,张娜,吴振奕 (厦门大学化学化工学院化学系,厦门 361005)

摘要:以 C₆₀及双齿膦 dppp为配体,在氮气氛下合成出 C₆₀Pt(dppp)配合物,采用质谱、元素分析、红外光谱、紫外可见 光谱以及光电子能谱等手段对产物进行表征.同时研究了产物的光电性能及氧化还原性能.光伏效应研究结果表明: 产物具有优良的光电转化性能,尤其是在 BQ/H₂Q介质电对中,光生电压最大达到 37 lmV;当 C₆₀Pt(dppp)薄膜厚度为 ILm时,光伏效应值最大.

关 键 词: 富勒烯; 铂配合物; 光电性能 **中图分类号**: O641; O644 **文献标识码**: A

Synthesis and Property of Noval Solar Energy of C_{60} Pt(dppp)

YANG Sheng2Yan, ZHANG Na, WU Zhen2Yi

(Department of Chemistry, Xiamen University, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen 361005, China)

Abstract The fillerene complex C_{60} Pt(dppp) was prepared by reacting C_{60} with dppp in nitrogen atmos2 phere The synthesized fullerene complex was characterized by means of Mass Spectrometry (MS), Elemen2 tal Analysis FT2R, UV2V is and XPS. Besides these, the photoelectric properties and redox property of this complex were also studied. The results show that the greatest value of photovotaic potential is 37 lmV in the benzoqu none/hydroquinone redox couple and the value of photovoltaic effects reach the maximum when the thickness of complex film is 11m. Based on the merits mensioned above, the complex has excellent photoe2 lectric properties, there fore it has potential application in solar cells. K ey words fillerene platinum complex, photoe lectric properties

自从 1985年 Kroto和 Smalley发现 C₆₀^[1]以来,在 世界范围内掀起了富勒烯及其衍生物的研究热潮,其 中富勒烯的化学修饰是富勒烯化学的一个重要的研 究方向之一.将具有特殊物理和光电化学性质的有机 或金属有机基团接枝到富勒烯上,可调节富勒烯的电 子密度及分子空间结构,使其具有某些特殊的性质, 如将卟啉^[23]、二茂铁^[4]、酞菁^[5]、共轭低聚物^[6]、四 硫富瓦烯 (TTF)及衍生物^[7]等不同电子基团通过共 价键连接到受体富勒烯上,所形成的授受化合物具有 显著的光电转化性能^[89].以 C₆₀衍生物 PCBM^[1011]为 电子受体材料所形成的共混体系的太阳电池获得了 6 7%的光电转化效率,有望得到实际应用^[12].本工 作合成了 G 型富勒烯双齿膦金属配合物 C₆₀ Pt(dp2 pp),同时对产物的氧化还原性能和光电性能进行 研究.

1 实验

1.1 C₆₀Pt(dppp)配合物的合成

1.1.1 Pt(dppp)2配合物的合成

配体 dppp(即 ph₂P(CH₂)₃Pph₂)按文献 [13]方 法合成,产物为白色粉末.

在 100mL的三颈瓶中加入0 25g dppp固体粉末,在 N₂保护下,加入 4mL无水乙醇和 1mL的 KOH(乙醇 2k) 溶液(该溶液由0 14g的 KOH和 4mL乙醇、1mL水配制 而成),充分搅拌加热到 65e.将 1mL溶有0 1g四氯铂酸 钾的水溶液慢慢滴加到上述溶液中, 20min内滴完.滴加 过程有淡黄色沉淀生成.冷却,离心分离,滤出淡黄色固 体,依次分别用 3mL无水乙醇、2mL冷水和2mL冷无水 乙醇洗涤,真空干燥,产物为黄色粉末状固体 164mg 产

收稿日期: 2008203211, 收到修改稿日期: 2008205219

基金项目: 福建省自然科学基金 (E0410001 E0110002)

作者简介: 杨绳岩 (19822), 女, 硕士研究生. 通讯联系人: 吴振奕. E2mail zywu@ xmu edu en

率 67.1%.

1. 1. 2 C₆₀Pt(dppp)的合成

在 100mL的三颈瓶中加入 49.5mg的 Pt(dppp)2 固体粉末,在 N2 保护下,将 15mL溶有 36mg C₆的甲 苯溶液加入到三颈瓶中,溶液呈墨绿色,继续搅拌 3h 过滤,收集墨绿色溶液,减压蒸馏,将产物溶液浓 缩至 3mL左右,加入正己烷,有墨绿色沉淀.用正己 烷和乙醚进行离心分离,真空干燥,得墨绿色粉末 28mg 产率42.2%.

1.2产物的表征

采用 LCQ DECA XP 型电喷雾质谱 (ES DM S) (美国 ThemoF innigan 公司)对最终产物的甲苯溶 液进行质谱分析;中间物及最终产物的元素分析采用 意大利 Cabo E ba21110型元素分析 (公分析;以 KBr 压片法在美国 Nicolet Avatar FT2R 360型傅立叶变换 红外光谱(义上测试原料 C₀和各中间配合物及产物的 红外光谱;以甲苯为溶剂,在岛津 UV22501型紫外可 见分光光度计上测试 C₀和各中间配合物及产物的紫 外 - 可见吸收光谱;采用美国 QUANTUM 2000 SCAN2 NNG ESCA M ICROPROBE 能谱(公分别测定产物中心 金属的光电子能谱.

1.3 性能测试

1.3.1 循环伏安研究

仪器和试剂: XHD2 型恒电位仪; LYZ2240型 函数记录仪; 普通三室电解槽; 铂丝、铂片(1cm²)、 饱和甘汞电极分别作为研究电极、辅助电极和参比 电极. 其中, 铂丝和铂片在使用前都在铬酸洗液里 浸泡, 二次水洗涤, 烘干使用. 甲苯、乙腈均为分析 纯试剂并重蒸; 四氟硼酸四丁基铵(TBABF₄)由 A R 级的氟硼酸和四丁基氢氧化铵中和后经两次重 结晶得到; 高纯氮.

向 0 lmol/L的 [CH₃(CH₂)₃]₄NBF₄的甲苯/乙 腈混合溶液(体积比,甲苯:乙腈=3B1)通氮除氧 15m n后进行电位扫描,扫描速度为 200mV/s 加入待 测物质,搅拌使之充分溶解,通氮除氧 15m n 后再次 进行电位扫描.

1.3.2 光伏效应的测定

介质溶液的配制: 以二次蒸馏水与 A R 级的有 关试剂分别配制 0. mol/L 的 KCl(O₂/H₂O)溶液, 0 00lmol/L的 I₆ (0 lmol/L)的 I 溶液, 0 lmol/L的 Fe(CN)³⁻₆ /Fe(CN)⁴⁻₆ 溶液和 0 01mol/L的 BQ(苯 醌)/H₂Q(氢醌)溶液.

研究电极的制作: GaAs单晶片背面以金属铟作 欧姆接触,正面用 / 3110表面处理液 (V_{H,s04} BV_{H202} B V_{H20} = 3BlBl)进行化学抛光处理,得到光洁表面. 然后 以溶剂挥发法在 GaAs电极表面沉积一层均匀的富勒 烯 **3**磷金属配合物薄膜. 光化学电池 (PEC) B以富勒烯配合物 砷化镓为研究电极, 铂片为辅助电极 (电极面积为 1 cm²), 饱和甘汞电极为参比电极.

光伏效应的测定: 在暗态和光照条件下分别测定 研究电极和参比电极之间的开路暗电位 Va 和开路光 电位 Voo, 研究电极和辅助电极之间短路暗电流 Ia 和 短路光电流 Ioo, 求出光生电压 \$V= Voo- Va, 光生电流 \$I= Ioo- Ia.

2 结果与讨论

2 1 反应原理

实验以三苯基膦为原料合成双齿膦配体 dppp Pph₃+ 2Liy ph₂PL i+ phL i

 $phLi+(CH_3)_3CChy LiCh+(CH)_3Cph$

2ph₂PL i+ BtCH₂CH₂CH₂Bry ph₂P(CH₂)₃Pph₂+ 2LBr 之后以乙醇为还原剂合成出低价的双齿膦铂金属配 合物 Pt(dppp)₂:

K₂PC₄+ 2ph₂PCH₂CH₂CH₂Pph₂y P((ph₂PCH₂CH₂CH₂Pph₂)₂+ 2KCl 最后采用配位取代法在常温下以 C₀取代一个双齿膦 配体合成出目标产物:

 C_{60} + Pt(dppp)₂y C_{60} Pt(dppp) + dppp 该法副反应少,产物易于提纯分离,得到了纯度较高的目标物.

2 2 产物的组成与结构

产物的元素分析结果为 C 77.95%、H 2 06%,与 理论值 (C 78 67% H 1 96%)基本一致.质谱测试结 果见图 1,1326 8处的强峰为产物的分子离子峰,在 720处为产物碎片 (C₆₀)峰.

形成 C₆₀Pt(dppp)后,紫外可见光谱 (图 2)发生明 显变化,如 C₆₀的 258 5 nm 和配体 dppp的 284nm 吸收 峰消失,而于 341、443 608、645nm 处出现新的吸收峰, 证明该目标产物已被合成,且以 G^{2} C₆₀的形式键合^[14].





与中间物 Pt(dppp)₂ 及纯 C₆₀相比, C₆₀ Pt(dppp)的红 外光谱 (图 3)也发生了较大的改变, 如中间物原来在 2925, 2851, 1583, 1480, 693 cm⁻¹的吸收峰分别向低波 数方向移至 2906, 2843, 1567, 1479, 691 cm⁻¹, 这主要 是因为 C₆₀ Pt(dppp)中的金属有机基团 Pt(dp2p)上 电子向 C₆₀转移导致其电子密度下降引起的. 而在 1027 cm⁻¹处吸收峰消失, 同时产物谱图中新增了 1418 cm⁻¹吸收峰, 526, 576, 1183, 1433 cm⁻¹处的吸收 为 C₆₀的特征吸收峰^[15].

测得的产物 C₆₀ Pt(dppp)的 4f_{7/2}电子结合能为 72.2 eV(见图 4),通过与具有相同配位环境的 0价的 Pt(PPh₈)₂M e (4f_{7/2} XPS值为72 0 eV)及 + 2价的 Pt (PPh₃)₂C l₂(Pt4f_{7/2}的 XPS值为 72 4 eV)(见表 1)比 较可推知,产物中心金属为低价态,预计为 0~+1 价.

根据以上分析推测产物的可能结构见图 5 中心 金属 Pt为 4配位,其中 ph₂PCH₂CH₂CH₂Pph 的两个 P配位原子占据两个配位位置,并与金属 Pt形成 6员 环的稳定结构, Pt以 G 形式与 C₆₀组成配合物,即 C₆₀ 上 C=C双键 (六员环与六员环之间)象乙烯那样与 Pt以 R2P形式键合, C=C双键 2个端点占据两个配 位位置,整个分子基本上呈 D_{2h}空间构型.

2.3 产物的化学性能

2.3.1 氧化还原性能

在 0 1~ - 1 8V电位范围内对 C₆₀及 C₆₀Pt(dppp) 进行循环伏安扫描,产物的循环伏安曲线如图 6所示, 在扫描电位范围内共出现三对明显的电位,三对还原 电位为 <1 = - 0 40V, <2 = - 0 85V, <3 = - 1 40V, 与 纯 C₆₀ (还原电位分别为 - 0 17V, - 0 77V, - 1 31V)





图 4 C_{60} Pt(dppp) Ptf_{7/2}的 XPS图谱 Fig 4 XPS spectrum of Pt4f_{7/2} for C_{60} Pt(dppp)

相比,分别向负电位方向移动了 0 23、0 08.0 09V,这 是因为 C₆₀与 Pt形成配合物后,向 Pt提供了孤电子 对,中心金属 Pt向 C₆₀的 P轨道反馈更多的电子,从 而使产物的 C₆₀的电子密度较纯 C₆₀大,吸引电子能力 变小,还原电位向负方向移动.

232 光伏性能

由于 C₆₀Pt(dppp)及 GaAs均为 n型半导体,因此 C₆₀Pt(dppp) GaAs形成了 n+ n型异质结复合电极. 它在不同介质电对中的光伏效应均比单纯的 GaAs高 (表 2),这是因为 n型半导体与介质溶液接触时,半 导体费米能级 E_{F(SC)}总是高于溶液中的氧化还原电对 费米能级 E_{F(O/R)},因此电子总是从半导体一侧流向溶 液,此时半导体带正电荷而形成耗尽层,能带向上弯 曲,弯曲的区间即为空间电荷区,n+ n型复合电极置 于介质溶液后,C₆₀Pt(dppp) 熔液与 C₆₀Pt(dppp) / GaAs同时形成两个空间电荷区,促使能带向

表 1 Pt4f_{7/2}的 XPS数据(eV) Table 1 XPS data of Pt4f_{7/2}

$C_{60} P t$	(dppp)	$Pt(dppp)_2$	$Pt(PPh_3)_2Me_2$	$Cl_2Pt(Pph_3)_2$	PtC 1	Pt	Pt(Pph ₃) $_4$	
P t4f _{7/2}	72. 20	71.25	72 00	73. 10	75.50	71 20	71 40	



图 5 C_{00} Pt(dppp)结构示意图 Fig 5 Structure diagram of the C_{60} Pt(dppp)



上弯曲量增大,并导致光照下有更大的光伏效应值, 所以 C₆₀Pt(dppp)/GaAs复合电极在四种介质电对的 光生电压均明显增大.同时对于 n+n型异质结复合 电极,由于产物的禁带宽度比较大 (> 1 5eV),在光照 条件下首先吸收太阳光谱中波长比较短的光而导致 电子跃迁,产生光生载流子,其光化学过程如下:

 $C_{60} Pt(dppp) \xrightarrow{hv} C_{60} Pt(dppp) \xrightarrow{*} C_{60} Pt(dppp) + e$ 而本征的 GaA s禁带宽度较小 (< 1.4eV), 则吸收太阳

光中波长较长的光,显然这种复合电极更能有效地利 用太阳能的光谱带,复合电极具有更大的光电转换 性能. C₆₀ Pt(dppp)/GaAs电极在四种不同的介质电对 中具有不同的光伏效应值,其中 BQ/H₂Q的光伏效应 值最大,该电对的光生电压最大值达到 371mV,光生 电流 16LA,其次是 O₂/H₂O,光生电压和光生电流最 大值分别为 328mV和43LA,第三是 J₆/I,\$V和 \$I 的最大值分别为 287mV和 33LA,为此,对 C₆₀Pt(dp2 pp)来说, BQ/H₂Q是较好的介质电对.不同氧化还原 电对对 C₆₀Pt(dpp)/GaAs电极光伏效应的影响主要 是由介质电对的费米能级高低不同引起的.当 C₆₀Pt (dppp)与不同费米能级的介质溶液接触时,达到平衡 的电极费米能级 E_{F(O,R)}在不同介质中的位置不同,因 而与受光后的准费米能级 E_{F(O,R)}。的差值 \$V也就不 同,显然电极在 BQ/H₂Q电对中的差值最大,所以在 BQ/H₂Q电对中复合电极具有较大的光生电压,因不同 介质电对的闭路电阻相同,光生电流也较大.

从表 2中数据看出,复合电极上的 C₆₀ Pt(dppp) 薄膜厚度不同,产生的光生电压 \$V和光生电流 \$I的 数值也不同, 以 O₂ /H₂O 为例, 当薄膜厚度 D为 0Lm 时的 \$V和 \$I值较小,分别为 190mV 和 3 5LA,随着 D的增大, \$V和 \$I值增大, 当 D为1.0Lm 时两者的数 值达到最大,此后 D进一步增大, \$V和 \$I 值迅速减 小.显然 C₆₀ Pt(dppp)薄膜厚度对光伏效应值有显著 的影响,当厚度从0开始增大时,一方面产生光生载 流子的 C₆₀Pt(dppp)分子增多,复合电极内电子和空 穴的浓度上升,光伏效应值增大,另一方面,电子和空 穴浓度增大必然导致电子 22 穴复合几率增大,使电 子空穴浓度保持在一稳定值,然而随着薄膜厚度的增 大,无疑将大大增加电极的电阻,导致光电流的下降 和光伏效应的减小,当薄膜厚度增加到 1Lm 时,光伏 效应从小达到最大,此时,前一因素起主导作用,当厚 度大于 1Lm后,光伏效应随厚度增大而迅速下降,此 时后一因素起主导作用.

表 2 不同氧化还原电对与不同 C ₆₀ Pt(dppp)厚度下的光伏效应(PVI	E)
--	----

Tab le 2	Value of photovol taic	effects of C_{60} P t(dppp)2GaAs in	d iffer en t	redox coup les with	differn en t
----------	------------------------	--------------------------	---------------	--------------	---------------------	--------------

th icknesses of C_{60} P t(dppp)

Deden constant	PVE	Film thickness D/Lm						
R ed ok couples		0. 0	0.5	1. 0	2 0	3 0	4 0	
BQ/H ₂ Q	\$V/mV	50	277	245	371	305	283	
	\$I/LA	3. 0	14. 0	5. 5	16. 0	2 0	2 0	
Γ ₃ /Γ	\$V/mV	147	278	287	187	140	138	
	\$I/LA	20. 0	20. 0	33. 0	12 0	5 5	6 0	
$Fe(CN)_{6}^{3-}/Fe(CN)_{6}^{4-}$	\$V/mV	31	173	180	161	129	133	
	\$I/LA	10	27	30	20	17	12	
O_2/H_2O	\$V/mV	190	242	324	328	215	201	
	\$I/LA	3. 5	4. 0	8.5	4.3	39	3 2	

3 结论

合成了新型富勒烯金属配合物 C₆₀Pt(dppp),采用质 谱、元素分析、红外光谱、紫外可见光谱、光电子能谱等手 段进行了表征,表明产物的中心金属 Pt以 G²形式与 C₆₀ 组成配合物.该配合物与 GaAs 组成 C₆₀Pt(dppp)/GaAs 复合电极后能更有效地利用太阳能的光谱带,具有更大 的光电转换性能,其光伏效应值主要受介质电对和薄膜 厚度的影响,在 BQ/H₂Q电对中具有较大的光生电压,其 最大值达到 37lmV,光生电流 16LA;薄膜厚度 D为 1Lm 时,光生电压和光生电流达到最大值.

参考文献:

- [1] KrotoH W, H eath J R, O. Brien S C, et al Nature 1985, 318 1622163.
- [2] Francis D Souza, Eranda Maligaspe, Paul A Karr, et al Chem Eur J. 2008, 14(2): 6742681.
- [3] Tohru Shiga Tomoyoshi Motohiro Thin Solid Films 2008 516

- (6): 120421208
- $[\,4\,]\,$ H irosh i Imahori Bull Chem Soc Jpn , 2007, 80(4): 6212636
- [5] Robert Koeppe, N Serdar Saricifici, et al Applied Physics Letters 2005, 87 (24): 244102/12244102/3.
- [6] Segura J L, Martin N, Guldi D M. Chem. Soc Rev., 2005, 34 (1): 31247.
- [7] Nazario Martin, Luis Sanchez et al Acc Chem Res, 2007, 40 (10): 101521024
- [8] Serap G neş Helmut Neugebau er, Niyazi Serdar Saricifici Chem. Rex, 2007, 107(4): 132421338
- [9] Barry C Thompson, Jean M J Fr chet Ang ev. Chem. Int Ed., 2008, 47(1): 58277.
- [10] 於黄忠, 彭俊彪. 高等学校化学学报, 2007, 28(12): 235922363
- [11] Lenes M, Koster L J A, et al Applied Physics Letters 2006, 88
 (24): 243502/12243502/3
- [12] K in J Y, Lee K H, Coates N E et al Science, 2007, 317. 2222 225
- [13] 杨瑞娜,谢文刚,林昆华,等.河南科学,1994,12(2): 992104.
- [14] Youichi Ishij Hidenori Hoshij Yasushi Hamada, et al Chen. Lett, 1994, (4): 8012804
- [15] Jon athan P H are, T John Denn is H arold W K roto, et al. J. Chem. Soc., Chem. Comm., 1991, (6): 4122413